



2SB1440 (3CG1440)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途：用于低频输出放大。

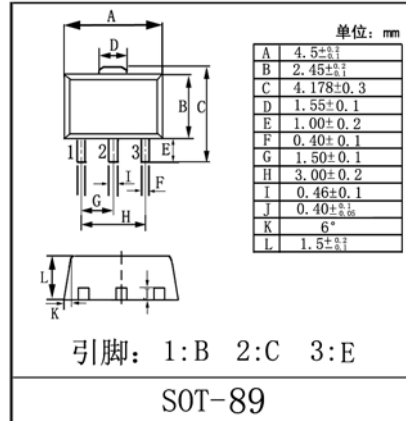
Purpose: For low frequency output amplification.

特点：饱和压降低，与 2SD2185 (3DG2185) 互补。

Features: Low $V_{CE(sat)}$, complementary to 2SD2185 (3DG2185).

极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	-50	V
V_{CE0}	-50	V
V_{EB0}	-5.0	V
I_C	-2.0	A
I_{CP}	-3.0	A
P_C^*	1.0	W
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



*:printed circuit board: copper foil area of 1cm² or more, and the board thickness of 1.7mm for C portion.

*:印制线路板要求: 与 C 脚接触的铜箔面积为 1cm² 或更大、厚度为 1.7mm。

电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=-10\mu\text{A}$ $I_E=0$	-50			V
V_{CE0}	$I_C=-1.0\text{mA}$ $I_B=0$	-50			V
V_{EB0}	$I_E=-10\mu\text{A}$ $I_C=0$	-5.0			V
$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-2.0\text{V}$ $I_C=-200\text{mA}$	120		340	
$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-2.0\text{V}$ $I_C=-1.0\text{A}$	60			
$V_{CE(sat)}$	$I_C=-1.0\text{A}$ $I_B=-50\text{mA}$		-0.2	-0.3	V
$V_{BE(sat)}$	$I_C=-1.0\text{A}$ $I_B=-50\text{mA}$		-0.85	-1.2	V
f_T	$V_{CB}=-10\text{V}$ $I_C=-50\text{mA}$ $f=200\text{MHz}$		80		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}$ $I_E=0$ $f=1.0\text{MHz}$		45	60	pF

$h_{FE(1)}$ 分档、印章/ $h_{FE(1)}$ Classifications、Marking:

$h_{FE(1)}$ 分档/ $h_{FE(1)}$ Classifications	R	S
$h_{FE(1)}$ 范围/ $h_{FE(1)}$ Range	120~240	170~340
印章/Marking	H1IR ^{**}	H1IS ^{**}

